



ОтУС представляет открытую лекцию Сопредседателя  
Консультативного научного Совета Фонда Сколково,  
лауреата Нобелевской премии,  
Академика Жореса Алфёрова



ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
Сколково  
ОТКРЫТЫЙ БУДУЩЕМУ

15 сентября 2011 года, 18.30



Тема лекции:  
**«Полупроводниковая революция XX века»**

Место проведения: Политехнический музей,  
Новая площадь  $\frac{3}{4}$ , подъезд 9, Большая аудитория

Регистрация на лекцию:  
<http://openu.timepad.ru/event/10618>

Прямая трансляция: <http://i-gorod.com/live/>

#### *Биография Ж.И. Алфёрова.*

Родился 15 марта 1930 в г. Витебске (Белоруссия). В декабре 1952 закончил ЛЭТИ. В январе 1953 поступил в ФТИ им. А.Ф. Иоффе, где защитил кандидатскую (1961) и докторскую (1970) диссертации. Член-корреспондент (1972), академик РАН (1979). С 1987 по 2003 — директор ФТИ.

Научные работы в области физики полупроводников, полупроводниковой и квантовой электроники, технической физики. Принимал участие в создании первых отечественных транзисторов, фотодиодов, мощных германиевых выпрямителей. Открыл явление сверхинжекции в гетероструктурах и показал, что в полупроводниковых гетероструктурах можно принципиально по-новому управлять электронными и световыми потоками. Создал «идеальные» полупроводниковые гетероструктуры. Исследованиями Ж.И. Алфёрова фактически создано новое направление — гетеропереходы в полупроводниках.

В 2000 совместно с Г. Кремером удостоен Нобелевской премии по физике за фундаментальные работы, заложившие основы современных информационных технологий посредством создания полупроводниковых гетероструктур, используемых в сверхвысокочастотной и оптической электронике.

Как было теоретически и экспериментально показано в работах, выполненных лауреатом в ФТИ, в полупроводниковых гетероструктурах — искусственных кристаллах, выращенных из различных по химическому составу полупроводников, — можно принципиально по-новому управлять электронными и световыми потоками. Разработанные на основе гетероструктур лазеры, светоизлучающие диоды, фотодиоды, транзисторы и солнечные батареи широко используются в современных системах передачи и хранения информации и в космической энергетике.



В настоящее время — вице-президент РАН, председатель Санкт-Петербургского научного центра РАН, ректор Академического университета. С 1972 г. по настоящее время — профессор, с 1973 по 2004 г. — заведующий базовой кафедрой оптоэлектроники Ленинградского электротехнического института (ныне Санкт-Петербургского электротехнического университета), с 1988 г. по настоящее время — декан физико-технического факультета Ленинградского Политехнического института (ныне Санкт-Петербургского государственного технического университета). Главный редактор журнала «Письма в Журнал технической физики».

Автор более 500 научных работ, в том числе 4 монографий, более 50 изобретений. Среди его учеников более сорока кандидатов и десяти докторов наук. Наиболее известные представители школы: чл.-корреспонденты РАН Д.З. Гарбузов и Н.Н. Леденцов, доктора физ.-мат. наук: В.М. Андреев, В.И. Корольков, С.Г. Конников, С.А. Гуревич, Ю.В. Жиляев, П.С. Копьев, др.

С 1989 по 1992 годы являлся народным депутатом СССР. С 1995 г. по настоящее время является депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. С 2000 г. является членом Комитета по науке и образованию Государственной Думы.